Cr³⁺ :Al₂O₃ 透明多晶陶瓷光谱特性分析

曾智江¹⁾ 杨秋红^{1)*} 徐 军²⁾

¹(上海大学材料科学与工程学院,上海 200072)
²(中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800)
(2005年2月4日收到,2005年3月21日收到修改稿)

对透光性良好的 Cr^{3+} :Al₂O₃ 透明多晶陶瓷的光谱性能进行了研究,其吸收光谱中吸收峰与单晶红宝石相一致,按吸收光谱和 Tanabe-Sugano 能级图,算出其晶场强度参数 D_q 及 Racah 参数 B 分别为 1792cm⁻¹,689cm⁻¹, D_q/B = 2.6 陶瓷中 Cr^{3+} 离子所处格位的晶体场强比单晶弱一些,但 Cr^{3+} :Al₂O₃ 透明陶瓷仍属于强场晶体材料;当 Cr^{3+} 掺杂浓度到达 0.8wt%时,陶瓷的发射谱仍保持较好的 R 线发射,随 Cr^{3+} 掺杂浓度的增大,激发峰位发生"红移".在 Cr^{3+} :Al₂O₃ 透明多晶陶瓷的荧光谱上,发现一个波长为 670nm 的发射峰,经激发谱确认为 Cr^{3+} 的发射峰.

关键词:氧化铝,透明陶瓷,离子格位,光谱性质 PACC:7845,7820,4270,8160D

1.引 言

Cr³⁺ :Al₂O₂ 是第一种具有激光发射的晶体,其 机械强度高 热膨胀系数小 导热率高 化学组分与 结构十分稳定 因此它是一种应用广泛的固体激光 工作物质,但是红宝石单晶的 Gr³⁺ 掺入量较少,一 般只有 0.05-0.1wt% 左右,这样激光输出功率受到 限制 而且红宝石单晶的生产成本高、生产周期长、 光学激活离子掺杂浓度低且掺杂不均匀,掺 Gr³⁺激 光玻璃虽然在成本和制备方面具有优势,但是它同 样存在不足之处,即发光效率低,一般不超过 15%[1] 从而阻碍其发展,而陶瓷激光介质研究兴起 及透明陶瓷制备技术的不断发展使掺 Cr³⁺ 氧化铝 陶瓷用于激光介质成为可能 特别是最近 已制备出 散射损耗小、高透明的多晶 YAG 陶瓷,并且产生了 高效的激光振荡 使得陶瓷激光介质引起人们广泛 关注^[2].掺Cr³⁺氧化铝陶瓷相对于单晶激光介质有 以下优点 成本低、生产效率高、可以制造大尺寸和 形状复杂的样品、激活离子掺杂浓度高等^[3].迄今, 掺 Cr³⁺ 氧化铝陶瓷光谱性能研究还不多,只有 Murotan^[3]等人曾用挤压模塑法制备掺 Cr³⁺ 氧化铝 陶瓷,指出其光谱性质与单晶相近,并提出掺 Cr³⁺

氧化铝透明陶瓷用作激光介质的可能性.本文主要 是对掺 Cr³⁺ 氧化铝透明陶瓷的吸收光谱和荧光光 谱进行研究和探讨.

2. 实验过程

实验采用传统无压烧结工艺制备掺 Cr³⁺ 氧化 铝透明陶瓷,其 Cr³⁺ 掺杂量分别为 0.1wt%, 0.2wt%,0.4wt%,0.8wt%,并依次标号为 C1,C2, C3,C4.烧结好的样品切片、研磨、双面抛光后,采用 日本 JASCO 公司的 V-570 型 UV/VIS/NIR 分光光度 计及 JASCO 公司的 FP-6500/6600 分光荧光计分别测 定了氧化铝透明陶瓷样品的吸收光谱、荧光光谱和 激发光谱.分光光度计测试波长范围为 190— 2500nm,分光荧光计的光源为 150W 的 Xe 灯,样品 的荧光光谱和激发光谱分辨率均为 1—2nm.

3. 结果与讨论

3.1. 吸收光谱

Cr 原子的电子外壳层排布为 $3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$,可以 形成 5 种 $3d^n$ (n = 1, 2, ..., 5)离子,主要有

[†]E-mail: yangqiuhongen@yahoo.com.en

Cr³⁺(3d³),Cr⁴⁺(3d²)和 Cr²⁺(3d⁴)3种.当 Cr 掺入不 同基质中时很容易失掉 2 个 3d 电子和 1 个 4s 电 子,变成 3d³ 形成 Cr³⁺.自由 Cr³⁺具有两个四重态⁴P 和⁴F,以及六个二重态²P,a²D,b²D,²F,²G和²H,基 态为⁴F.

由于 Cr^{3+} 具有很高的八面体择位能,因此 Cr^{3+} 将尽可能处于八面体配位场. Cr^{3+} 在八面体晶体场 中的能级如图 1 所示,从基态⁴ A₂ 的吸收跃迁主要 有两类,一类是自旋允许的跃迁,如⁴ A₂ →⁴ T₂,⁴ T₁ 等,其特征是吸收强,峰很宽;另一类是自旋禁戒的 跃迁,如⁴ A₂→² E,² T₁,² T₂等,其特征是吸收弱,接近 线性吸收^[4].

掺 Cr³⁺ 氧化铝透明陶瓷照片如图 2 所示,样品 厚度为 1mm,并具有良好的透光性.



图 1 八面体晶体场中 Cr³⁺离子能级图

图 3 (a) (b) 分为 Cr³⁺: Al₂O₃ 红宝石单晶和



图 2 掺 Cr³⁺氧化铝透明陶瓷照片 ,Cr³⁺掺入量(a)0.1wt%,(b) 0.8wt%

 Cr^{3+} :Al₂O₃ 透明多晶陶瓷在室温下的吸收光谱 ,从 图中可以看出氧化铝透明陶瓷吸收光谱与单晶吸收 光谱很相似^[5,6].吸收峰位置在 402nm 和 558nm 处 , 分别对应 Cr^{3+} 离子⁴A₂→⁴T₁ 和⁴A₂→⁴T₂ 的能级跃 迁 这两个跃迁是自旋允许的 ,吸收峰宽而强 ,这些 吸收峰位置与单晶红宝石相符合.

根据 Tanabe-Sugano 理论^[7],可以求得 $E({}^{4}T_{1})$ 和 $E({}^{4}T_{2})$ 能级与晶场强度参数 D_{q} 及 Racah 参数 B 的 关系式

$$E({}^{4}T_{2}) - E({}^{4}A_{2}) = 10D_{q}$$
, (1)

$$E({}^{4}T_{1}) - E({}^{4}A_{2}) = 11D_{q} + 7.5B.$$
 (2)

将晶场能级 $E({}^{4}T_{1}) = 24876 \text{cm}^{-1}(402 \text{nm}),$ $E({}^{4}T_{2}) = 17921 \text{cm}^{-1}(558 \text{nm}) 代入方程(1)(2),可以$ $得到 <math>D_{q} = 1792 \text{cm}^{-1}, B = 689 \text{cm}^{-1}, D_{q}/B = 2.6 >$ 2.3,所以 $\text{Cr}^{3+}: \text{Al}_{2}\text{O}_{3}$ 透明陶瓷属于强场晶体材 料^[8].强场材料表现为锐线发射,较弱的电声耦合, 较小的非辐射跃迁概率,斯托克斯位移小等特点.



图 3 (a) 红宝石单晶和(b) 掺 Cr³⁺ 氧化铝透明陶瓷的室温吸收光谱

3.2. 荧光光谱和激发光谱

Cr³⁺ :Al₂O₃ 透明多晶陶瓷的室温荧光光谱如图 4 所示 发射峰在 670nm (14925cm⁻¹)和 697nm (14347 cm⁻¹)左右.697nm 处的发射峰为 R 线发射,在红宝 石单晶中 Cr³⁺ 的 R 线由单独的 R₁, R₂ 线组成, 其发 射峰位于 694nm 和 693nm ,二者峰位相差仅为 1nm. 因实验分光荧光计的分辨率为 1—2nm,因而 R₁, R₂ 无法单独分辨.另外 Al, O, 为六方晶系结构,其光学 性能表现为各向异性 因而红宝石单晶发射谱表现 出偏振特性 而氧化铝陶瓷宏观上表现为各向同性, 它是由许多取向各异的小晶粒组成 因此各个小晶 粒的发射谱峰位会有所差别.图 4 中 697nm 处的荧 光发射是由这些小晶粒发射峰的叠加、形成一个较 宽的发射谱带,此外、陶瓷中各个小晶粒之间还存在 晶界 晶界上存在许多空位、位错等缺陷 使得 Al₂O₃ 晶格畸变较大,其离子排布构成不规则多面体,当 Gr³⁺处于这些不规则多面体格位当中时,因这些 Cr³⁺的晶体场强都有所差别,使得 Cr³⁺的跃迁所需 能量稍有不同 从而引起谱峰变宽 形成一个较宽的 发射带.因此 697nm 处的荧光发射是由发射峰叠加 而成的一个复合谱带,除发射峰强度外,陶瓷荧光光 谱并没有随掺 Gr³⁺ 浓度增加而出现畸异结构 特别 是当 Cr³⁺ 浓度到达 0.8wt%(C4 样品),陶瓷的发射 谱仍保持较好的 R 线发射 这表明 Cr³⁺ 在氧化铝陶 瓷中分布很均匀,且大都处于未畸变的八面体格位 当中。

Cr³⁺ :Al₂O₃ 透明多晶陶瓷在波长为 670nm 附近 的另一发射峰,这在 Cr³⁺ :Al₂O₃ 单晶中和其他掺 Cr³⁺氧化铝陶瓷中从未出现过.对该波长所做的激 发谱如图 5(a)所示,由图可知,其峰位仍表现出



图 4 掺 Cr³⁺ 氧化铝透明陶瓷的室温荧光光谱

 Cr^{3+} 离子激发谱,因此 670nm 处的发射峰应该是" 蓝 移 '的另一组 R 线,造成 R 线蓝移,可能是由于氧化 铝透明陶瓷的烧结过程中引入的烧结助剂如 MgO, La₂O₃等使得 Cr^{3+} 在 Al₂O₃,八面体中所在格位位置 发生变化所造成.这组 R 线也应该是 R_1 , R_2 线两个 峰的叠加,从而使得发射峰较宽,其宽化原因与 697nm处的峰相一致.从以上实验结果可以看出 Cr^{3+} :Al₂O₃透明多晶陶瓷在波长 670nm 和 697nm 两 处都有可能实现激光输出.

根据激发谱的峰位,C1 样品选择 578nm(17301 cm⁻¹)作为激发光,这个荧光谱相对于激发谱的斯托克斯位移为 $\Delta E_s = 17301 - 14347 = 2954 cm^{-1}. 而 C2,C3 和 C4 样品的激发峰值分别在 590nm(16949 cm⁻¹),594nm(16835 cm⁻¹)和 598nm(16722 cm⁻¹)左右 因而 C2,C3 和 C4 样品的荧光谱相对于激发谱的斯托克斯位移分别为 2602 cm⁻¹,2488 cm⁻¹和 2375 cm⁻¹.因此,随着 Cr³⁺离子掺杂浓度的增大斯托克斯位移减小,这说明 Cr³⁺离子吸收带有所变$



图 5 室温下掺 Cr³⁺ 氧化铝透明陶瓷的激发光谱 (a)发射峰为 670nm; (b)发射峰为 697nm

窄 同时 ΔE_s 减小说明⁴T₂($t_2^2 e$)→⁴A₂(t_2^3)跃迁的电 声耦合减弱 这样有利于获得较高的发射强度.

从图 5(b)上可以看出 随着 Cr³⁺ 浓度的增加, 697nm 荧光的激发光谱峰值向长波扩展,由于 Cr³⁺ 离子与 Al³⁺ 离子半径的失配(Cr³⁺:0.061nm ,Al³⁺: 0.053nm), Cr³⁺对 Al³⁺的取代,将会使 Al₂O₃ 晶胞发 生畸变.因此,Cr³⁺在Al,O,中的格位由于掺杂浓度 的增大而使八面体配位的晶胞对称性畸变程度增 大 减少了配位场 即低对称性非正常格位(非八面 体配位、或间隙位)的粒子数随掺杂浓度的增加导致 晶格畸变程度增加,从而减弱了 Cr³⁺ 离子的能级分 裂. 使 原 本 处 于 正 常 的 能 级 分 裂 强 度(10D。~ 17.900cm⁻¹ 格位的产生峰位吸收的离子数减少了, 因而使得峰位发生"红移". 而陶瓷中微量添加剂有 可能进一步加剧这种畸变,并产生更多的晶体缺陷, 晶格缺陷在光的辐照下 容易产生色心吸收 激发谱 相对于吸收光谱 激发谱的峰位置发生偏移 激发谱 峰位在 578nm 至 598nm 处, 而吸收谱的峰位在 550nm 左右,这说明发光离子浓度增加时,从激发态

向基态跃迁 具有一定的无辐射跃迁概率.

4. 结 论

掺 Cr^{3+} 氧化铝透明陶瓷其吸收峰与红宝石单 晶相一致,在 402nm 和 558nm 处有较强的吸收峰; Cr^{3+} : Al_2O_3 透明多晶陶瓷晶场强度参数 D_q 及 Racah 参数 B 分别为 1792cm⁻¹, 689cm⁻¹, $D_q/B =$ 2.6 陶瓷中 Cr^{3+} 离子所处格位的晶体场强比单晶弱 一些, Cr^{3+} : Al_2O_3 透明陶瓷仍属于强场晶体材料;陶 瓷中存在 R荧光谱线,并以锐线发射为主,特别是 当 Cr^{3+} 浓度达到 0.8wt%,陶瓷的发射谱仍保持较好 的 R 线发射;所有陶瓷样品在 670nm 处有一个新的 Cr^{3+} 发射峰. Cr^{3+} 离子与 Al^{3+} 离子半径的失配和微 量添加剂的存在使得 Al_2O_3 晶胞发生畸变,产生晶 体缺陷,随 Cr^{3+} 掺杂浓度的增大激发谱峰位发生 "红移".从以上光谱的特性看, Cr^{3+} : Al_2O_3 透明多晶 陶瓷有较好的光谱性能,有可能在高掺杂浓度下,用 作激光介质,实现 670nm 和 697nm 两处的激光输出.

- [1] Beall G H 1985 J. Non-Cryst. Solids. 73 413
- [2] Lu J, Prabhu M, Song J et al 2000 Appl. Phys. B 71 469
- [3] Murotani H , Mituda T , Wakaki M et al 2000 Jpn. J. Appl. Phys. 39 2748
- [4] Cao G X, Hu H F, Zhou S G 2002 Acta Optica Sinica 22 226 (in Chinese] 曹国喜、胡和方、周世 2002 光学学报 22 226]
- [5] Cronemeyer D C 1956 J. Opt. Soc. Am. 56 1703
- [6] Nelson D F , Sturge M D 1965 Phy. Rev. 137 A1117
- $\left[\ 7 \ \right]$ Tanabe Y , Sugano S 1954 J . Phys. Soc. Japa . 9 753
- [8] Kenyon P T, Andrews L, McCollum B C et al 1982 IEEE J. Quant. Electron. QE-18 1189

5449

Spectroscopic characteristics of Cr^{3+} :Al₂O₃ polycrystalline transparent alumina ceramics

Zeng Zhi-Jiang¹) Yang Qiu-Hong¹) Xu Jun²)

¹) (School of Materials Science and Engineering , Shanghai University , Shanghai 200072 , China)

² (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics , Chinese Academy of Sciences , Shanghai 201800 , China)

(Received 4 February 2005; revised manuscript received 21 March 2005)

Abstract

Spectral properties of transparent polycrystalline Cr^{3+} : Al_2O_3 ceramics were studied. The results indicated that the absorption peaks of polycrystalline Cr^{3+} : Al_2O_3 ceramics coincide with the absorption spectrum of a ruby single crystal. The crystal field and Racah parameters were calculated according to the Tanabe-Sugano energy level diagram and absorption spectra. The crystal field intensity of Cr^{3+} : Al_2O_3 polycrystalline ceramics is almost the same as that of Cr^{3+} : Al_2O_3 single crystal , and the characteristics of the emission spectra still retains the *R*-line emission even as the Cr^{3+} concentration increases up to 0.8wt%. In particular , one 670nm emission peak of Cr^{3+} was first found in the polycrystalline ceramics.

Keywords : alumina , polycrystalline transparent ceramics , ion site , spectroscopic characteristics PACC : 7845 , 7820 , 4270 , 8160D